(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-259709

(43)公開日 平成8年(1996)10月8日

4=-11-							
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所
CO8J 5/18	CFG		C08J	5/18		CFG	
B 2 9 C 41/12		7310-4F	B 2 9 C	41/12			
C08K 5/42	KLA		C08K	5/42		KLA	
C08L 79/00	LRC		C08L	79/00		LRC	
H01B 1/12			H01B	1/12		G	
		審査請求			OL	(全 8 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平7-67513		(71)出願	ل 000003	964		
				日東電	工株式	会社	
(22)出願日	平成7年(1995)3月27日			大阪府	淡木市	下穂積1丁目	1番2号
			(72)発明:				
						下穂積1丁目	1番2号 日東
					式会社		
			(72)発明	者 中村	正雄		
				大阪府	淡木市	下穂積1丁目	1番2号 日東
				電工株	式会社	内	
			(72)発明			·	
				大阪府	一· 茨木市	下穂積1丁目	1番2号 日東
				電工株	式会社	内	
			1				

(54) 【発明の名称】 半導電性樹脂シート及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】環境の変化に対しても、安定した導電性を有するポリイミドと(脱)ドープ状態のポリアニリンとのポリマーブレンドからなる半導電性樹脂シートの製造方法を提供することにある。

【構成】本発明による半導電性樹脂シートの好ましい製造方法は、ポリアミド酸と脱ドープ状態のポリアニリンとこの脱ドープ状態のポリアニリンをドーピングして導電性とすることができるドーパントを含む製膜溶液を基材上にキャステイングし、基材上に上記溶液の層を形成し、60~200℃の温度に加熱して、基材上に樹脂シートを形成し、次いで、その樹脂シートを基材から剥離し、その後、この樹脂シートを250~400℃の温度に加熱して、ポリアミド酸をイミド化させることを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】ポリイミドと脱ドープ状態のポリアニリン とのポリマーブレンドからなり、弾性率が200kgf/mm 2 以上であり、体積抵抗率が $10^7 \sim 10^{14} \Omega \cdot cm$ の範 囲にある半導電性樹脂シート。

【請求項2】ポリアミド酸と脱ドープ状態のポリアニリ ンとを含む製膜溶液を基材上にキャステイングし、基材 上に上記製膜溶液の層を形成し、60~200℃の温度 に加熱して、基材上に樹脂シートを形成し、次いで、そ の樹脂シートを基材から剥離し、その後、この樹脂シー 10 トを250~400℃の温度に加熱して、ポリアミド酸 をイミド化させることを特徴とするポリイミドと脱ドー プ状態のポリアニリンとのポリマーブレンドからなり、 弾性率が200kgf/mm²以上であり、体積抵抗率が10 7~1014Ω·cmの範囲にある半導電性樹脂シートの製 造方法。

【請求項3】ポリアミド酸とポリアニリンとこのポリア ニリンをドーピングして導電性とすることができるドー パントを含む製膜溶液を基材上にキャステイングし、基 材上に上記製膜溶液の層を形成し、60~200℃の温 20 度に加熱して、基材上に樹脂シートを形成し、次いで、 その樹脂シートを基材から剥離し、その後、この樹脂シ ートを250~400℃の温度に加熱して、ポリアミド 酸をイミド化させることを特徴とする半導電性樹脂シー トの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ポリイミドと共に、脱 ドープ状態又はドープ状態のポリアニリンを含むポリマ 性にすぐれる半導電性樹脂シートと、そのような半導電 性樹脂シートの製造方法に関する。このような半導電性 樹脂シートは、例えば、電池の電極材料、電磁シールド 材、静電吸着用フィルム、帯電防止材、画像形成装置部 品、電子デバイス等において好適に用いることができ る。

[0002]

【従来の技術】従来、ポリイミドにカーボン、カーボン 繊維、グラファイト、金属粒子、金属酸化物粒子等の導 電性充填剤を配合することによって、ポリイミドを導電 40 性にすることができることは、既に知られている。しか しながら、これらの導電性充填剤をポリイミドに配合し て、導電性を有するシートとしたとき、得られるシート は、機械特性に劣り、特に、シートに「しなやかさ」が なく、シートの加工時や使用時に、それに加わる張力に 耐えることができず、切断したり、又は破れたりする問 題がある。また、このような方法によれば、得られるポ リイミドのシートにおいて、所要の表面抵抗率を再現性 よく、且つ、均一に付与することが困難である。

【0003】他方、導電性ポリアニリンと他の樹脂とか 50 あることが好ましい。

2

らなる半導電性ポリマーブレンドは、例えば、特開平4 -63865号公報に記載されているように、既に知ら れている。この半導電性ポリマーブレンドは、脱ドープ 状態、即ち、ドーパントによってドーピングされていな いポリアニリンと他の樹脂との混合物を調製し、その後 にこれにドーパントにてドーピング処理を施してなるも のであるので、水分や熱によってドーパントが脱ドープ しやすく、従って、その電気抵抗値が環境によって変化 しやすいという問題を有している。更に、上記方法によ って導電性ポリマーブレンドを得るには、製膜、ドーピ ング、洗浄及び乾燥という多くの工程を要するという問 題もある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来の半導 電性樹脂シートにおける上述したような問題を解決する ためになされたものであって、環境の変化に対しても、 安定した半導電性を有する半導電性樹脂シート及びその 製造方法を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明による半導電性樹 脂シートは、ポリイミドと脱ドープ状態のポリアニリン とのポリマーブレンドからなり、弾性率が200kgf/mm ² 以上であり、体積抵抗率が10⁷ ~10¹⁴ Ω·cmの範 囲にあることを特徴とする。

【0006】このような半導電性樹脂シートは、本発明 に従って、ポリアミド酸と脱ドープ状態のポリアニリン とを含む製膜溶液を基材上にキャステイングし、基材上 に上記製膜溶液の層を形成し、60~200℃の温度に 加熱して、基材上に樹脂シートを形成し、次いで、その ーブレンドからなり、半導電性を有し、強靱で機械的特 30 樹脂シートを基材から剥離し、その後、この樹脂シート を250~400℃の温度に加熱して、ポリアミド酸を イミド化させることによって得ることができる。

> 【0007】更に、本発明によれば、ポリイミドと共 に、ドープ状態のポリアニリン、即ち、ドーパントによ ってドープされているポリアニリンを含むポリマーブレ ンドからなり、より高い導電性を有する半導電性樹脂シ ートの製造方法も提供される。このような半導電性樹脂 シートは、本発明に従って、ポリアミド酸とポリアニリ ンとこのポリアニリンをドーピングして導電性とするこ とができるドーパントを含む製膜溶液を基材上にキャス テイングし、基材上に上記製膜溶液の層を形成し、60 ~200℃の温度に加熱して、基材上に樹脂シートを形 成し、次いで、その樹脂シートを基材から剥離し、その 後、この樹脂シートを250~400℃の温度に加熱し て、ポリアミド酸をイミド化させることによって得るこ とができる。

【0008】本発明によれば、上記ポリマーブレンドか らなる半導電性樹脂シートにおいて、脱ドープ状態又は ドープ状態のポリアニリンは、1~90重量%の範囲で 3

【 0009】本発明において、半導電性樹脂シートとは、体積抵抗率が $10^7 \sim 10^{15}\,\Omega$ ・cmの範囲にある樹脂シートをいう。

【0010】ポリアミド酸は、既に知られているように、テトラカルボン酸二無水物又はその誘導体とジアミンとのほぼ等モル混合物を有機極性溶媒に溶解させ、溶液状態で反応させることによって、溶液として得ることができる。従って、ポリアミド酸は、ポリイミドの前駆体として調製されるものであって、このようなポリアミド酸を加熱することによって、不溶不融のポリイミドを 10形成する。

【0011】本発明によれば、このようなポリアミド酸として、特に、芳香族テトラカルボン酸二無水物と芳香族ジアミンとの反応によって得られるポリアミド酸が好ましく用いられる。

【0012】本発明によれば、上述したようにして、ポリアミド酸の溶液を調製し、別に、脱ドープ状態のポリアニリンの溶液か、又は脱ドープ状態のポリアニリンとこのポリアニリンをドーピングして導電性とすることができるドーパントを含む溶液を調製し、これらの溶液を20混合して、製膜溶液とし、これを適宜の基材、例えば、ガラス、金属、樹脂等からなる等の外表面又は内表面上にキャステイングし、乾燥させ、加熱し、ポリアミド酸をイミド化することによって、ボリイミドとボリアニリンとのポリマーブレンドからなる半導電性樹脂シートを得ることができる。上記管状の基材を用いるときは、チューブ状の製品を得ることができるが、本発明においては、このようなチューブ状の製品もシートに含めることとする。

【0013】ポリアミド酸の調製において、上記芳香族テトラカルボン酸二無水物としては、例えば、ピロメリット酸二無水物、3,3',4,4' ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、3,3',4,4' ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,3,3',4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、2,3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1,2,5,6ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1,4,5,8ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2,2'ービス(3,4ージカルボキシフェニル)プロパン二無水物、ビス(3,4ージカルボキシフェニル)スル 40ホン二無水物等を挙げることができる。これらは単独で用いられてもよく、また、複数が併用されてもよい。*

4

*【0014】上記芳香族ジアミンとしては、例えば、4,4'ージアミノジフェニルエーテル、4,4'ージアミノジフェニルメタン、pーフェニレンジアミン、mーフェニレンジアミン、ベンチジン、3,3'ージメトキシベンチジン、4,4'ージアミノジフェニルスルホン、4,4'ージアミノジフェニルスルフイド、4,4'ージアミノジフェニルフロパン、2,2ービス〔4ー(4ーアミノフェノキシ)フェニル〕プロパン等を挙げることができる。これらも、単独で用いられてもよく、また、複数が併用されてもよい。

【0015】また、上記有機極性溶媒としては、例えば、Nーメチルー2ーピリリドン、N,N'ージメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチレンホスホルトリアミド等を挙げることができる。これらの有機極性溶媒には、必要に応じて、クレゾール、フェノール、キシレノール等のフェノール類、ヘキサン、ベンゼン、トルエン等の炭化水素類等を混合することができる。これらの溶剤も、単独で、又は2種以上の混合物として用いられる。

0 【0016】上記芳香族テトラカルボン酸二無水物と芳香族ジアミンを上記溶媒中で溶液状態で反応させて、ボリアミド酸の溶液を得る際の有機溶媒中での上記無水物とジアミンとからなる原料量の濃度は、通常、5~30重量%、好ましくは10~25重量%の範囲である。用いる無水物とジアミンとにもよるが、通常、80℃以下、好ましくは、5~50℃の範囲の温度で約2~10時間反応させることによって、ボリアミド酸を溶液として得ることができる。

【0017】芳香族テトラカルボン酸二無水物と芳香族 30 ジアミンとを溶液状態で反応させるとき、反応の進行と 共に、溶液の粘度が上昇するが、本発明においては、温 度30℃にてNーメチルー2ーピドリドン溶液として測 定した固有粘度が0.5以上のポリアミド酸溶液を調製 し、これを用いることが好ましい。このように、固有粘 度が0.5以上のポリアミド酸溶液を用いることによっ て、機械強度の信頼性がすぐれるシートを得ることがで きる。

【0018】次に、本発明において用いるポリアニリンは、一般式(I)

40 [0019]

【化1】

【0020】(式中、m及び n はそれぞれ繰り返し単位 **+n=1 である。)で表されるキノンジイミン構造単位 中のキノンジイミン構造単位及びフエニレンジアミン構 及びフエニレンジアミン構造単位を主たる繰り返し単位 造単位のモル分率を示し、0 < m < 1、0 < n < 1、m × 50 として有し、脱トープ状態において溶剤に可溶性のポリ

アニリンである。以下、このようなポリアミドをキノン **ジイミン・フェニレンジアミン型ポリアニリンというこ** とがある。このようなポリアニリンの性質と製造につい ては、特開平3-28229号公報に詳細に記載されて いる。

【0021】特に、本発明において用いるポリアニリン は、特開平3-28229号公報に記載されているよう に、脱ドープ状態において457.9 nmの波長の光で励 起して得られるレーザー・ラマンスペクトルにおけるパ ラ置換ベンゼンの骨格振動のうち、1600cm-1よりも 高波数にあらわれる骨格延伸振動のラマン線の強度 I a と1600cm⁻¹よりも低波数にあらわれる骨格延伸振動 のラマン線強度 I bの比 I a / I bが1.0以上であるこ とが好ましい。更に、本発明において用いるポリアニリ ンは、N-メチルピロリドン中、30℃で測定した極限 粘度[n]が0.40d1/g以上であることが好ましい。 かかるレーザー・ラマンスペクトル特性を有するポリア ニリンは、特開平3-28229号公報に詳細に記載さ れているように、従来より知られているポリアニリンに 比べて、高分子量であり、溶剤可溶性である点で区別さ れ、更に、構造的にも区別され得る。

【0022】本発明において用いる上記キノンジイミン ・フェニレンジアミン型ポリアニリンであって、脱ドー プ状態において有機溶剤に可溶性であり、所定の極限粘 度と前述したレーザー・ラマンスペクトル特性を有する ポリアニリンは、特開平3-28229号公報に詳細に 記載されているように、酸解離定数 pKa値が3.0以下で あるプロトン酸の存在下に溶剤中にてアニリンに温度を 5℃以下、好ましくは0℃以下の温度を保持しつつ、標 準水素電極を基準とする還元半電池反応における起電力 として定められる標準電極電位が0.6 V以上である酸化 剤の水溶液をアニリン1モル当たりに、酸化剤の1モル を、酸化剤1分子を還元するのに必要な電子数で割った 量として定義される当量で、2当量以上、好ましくは2 ~2.5 当量徐々に加えて、上記プロトン酸にてドープさ れたアニリンの酸化重合体(以下、ドープされたポリア ニリンという。)を生成させ、次いで、このドープされ たポリアニリンを塩基性物質によって脱ドープすること によって得ることができる。

ンを酸化重合して、ドープ状態のポリアニリンを得、次 いで、このポリアニリンを脱ドープして得られるポリア ニリンは、高分子量を有し、しかも、種々の有機溶剤に 溶解する。かかる有機溶剤としては、N-メチルー2-ピロリドン、N,N -ジメチルアセトアミド、N,N -ジメ チルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、1,3-ジメ チルー2-イミダゾリジノン、スルホラン等を挙げるこ とができる。このような脱ドープ状態のポリアニリンの 溶解度は、ポリアニリンの平均分子量や溶剤にもよる

の溶液を得ることができる。本発明において用いるこの ような脱ドープ状態のポリアニリンは、それ自体が半導 電性を有する。

6

【0024】本発明によれば、前述したように、ポリア ミド酸と脱ドープ状態のポリアニリンと(このポリアニ リンをドーピングして導電性とすることができるドーパ ントと)を含む製膜溶液を調製し、この製膜溶液を適宜 の基材、例えば、ガラス板上にキャステイングし、製膜 溶液の層を基材上に形成し、60~200℃の温度に加 熱して、基材上に樹脂シートを形成し、次いで、その樹 脂シートを基材から剥離し、その後、この樹脂シートを 250~400℃の温度に加熱して、ポリアミド酸をイ ミド化させることによって、ポリイミドと(脱)ドープ 状態の導電性ポリアニリンとのポリマーブレンドからな る半導電性樹脂シートを得ることができる。

【0025】本発明において、ポリアニリンをドーピン グして、導電性とするためのドーパントとしては、プロ トン酸を好ましく用いることができる。ドーパントとし て好ましいプロトン酸は、酸溶解定数 pKa値が4.8以下 であるプロトン酸である。そのようなプロトン酸とし て、例えば、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、ホウフッ化水 素酸、リンフッ化水素酸、過塩素酸等の無機酸のほか、 酸溶解定数 pKa値が4.8以下である有機酸を挙げること ができる。

【0026】本発明において用いる有機酸は、例えば、 有機カルボン酸又はフェノール類であって、好ましく は、酸解離定数 pKa値が4.8以下であるものである。こ のような有機酸としては、脂肪族、芳香族、芳香脂肪 族、脂環式等の一又は多塩基酸を含む。このような有機 酸は、水酸基、ハロゲン、ニトロ基、シアノ基、アミノ 基等を有していてもよい。従って、かかる有機酸の具体 例として、例えば、酢酸、n-酪酸、ペンタデカフルオ ロオクタン酸、ペンタフルオロ酢酸、トリフルオロ酢 酸、トリクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、モノフルオロ酢 酸、モノブロモ酢酸、モノクロロ酢酸、シアノ酢酸、ア セチル酢酸、ニトロ酢酸、トリフエニル酢酸、ギ酸、シ ュウ酸、安息香酸、m-ブロモ安息香酸、p-クロロ安 息香酸、mークロロ安息香酸、pークロロ安息香酸、o -ニトロ安息香酸、2,4ージニトロ安息香酸、3,5ージ 【0023】このように、プロトン酸の存在下にアニリ 40 ニトロ安息香酸、ピクリン酸、oークロロ安息香酸、p -ニトロ安息香酸、m-ニトロ安息香酸、トリメチル安 息香酸、pーシアノ安息香酸、mーシアノ安息香酸、チ モールブルー、サリチル酸、5-アミノサリチル酸、o -メトキシ安息香酸、1,6-ジニトロ-4-クロロフェ ノール、2,6-ジニトロフェノール、2,4-ジニトロフ ェノール、p-オキシ安息香酸、ブロモフェノールブル ー、マンデル酸、フタル酸、イソフタル酸、マレイン 酸、フマル酸、マロン酸、酒石酸、クエン酸、乳酸、コ が、重合体の $0.5\sim100\%$ が溶解し、 $1\sim30$ 重量% 50 コール酸、チオグリコール酸、エチレンジアミン-N,N'

- 二酢酸、エチレンジアミン-N,N,N',N'-四酢酸等を挙げることができる。

【0027】また、有機酸は、スルホン酸又は硫酸基を 有するものであつてもよい。このような有機酸として は、例えば、アミノナフトールスルホン酸、メタニル 酸、スルファニル酸、アリルスルホン酸、ラウリル硫 酸、キシレンスルホン酸、クロロベンゼンスルホン酸、 メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、1-プロパンス ルホン酸、1-ブタンスルホン酸、1-ヘキサンスルホ ン酸、1-ヘプタンスルホン酸、1-オクタンスルホン 10 酸、1-ノナンスルホン酸、1-デカンスルホン酸、1 ードデカンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、スチレン スルホン酸、pートルエンスルホン酸、ナフタレンスル ホン酸、エチルベンゼンスルホン酸、プロピルベンゼン スルホン酸、ブチルベンゼンスルホン酸、ペンチルベン ゼンスルホン酸、ヘキシルベンゼンスルホン酸、ヘプチ ルベンゼンスルホン酸、オクチルベンゼンスルホン酸、 ノニルベンゼンスルホン酸、デシルベンゼンスルホン 酸、ウンデシルベンゼンスルホン酸、ドデシルベンゼン スルホン酸、ペンタデシルベンゼンスルホン酸、オクター デシルベンゼンスルホン酸、ジエチルベンゼンスルホン 酸、ジプロピルベンゼンスルホン酸、ジブチルベンゼン スルホン酸、メチルナフタレンスルホン酸、エチルナフ タレンスルホン酸、プロピルナフタレンスルホン酸、ブ チルナフタレンスルホン酸、ペンチルナフタレンスルホ ン酸、ヘキシルナフタレンスルホン酸、ヘプチルナフタ レンスルホン酸、オクチルナフタレンスルホン酸、ノニ ルナフタレンスルホン酸、デシルナフタレンスルホン 酸、ウンデシルナフタレンスルホン酸、ドデシルナフタ レンスルホン酸、ペンタデシルナフタレンスルホン酸、 オクタデシルナフタレンスルホン酸、ジメチルナフタレ ンスルホン酸、ジエチルナフタレンスルホン酸、ジプロ ピルナフタレンスルホン酸、ジブチルナフタレンスルホ ン酸、ジペンチルナフタレンスルホン酸、ジヘキシルナ フタレンスルホン酸、ジヘプチルナフタレンスルホン 酸、ジオクチルナフタレンスルホン酸、ジノニルナフタ レンスルホン酸、トリメチルナフタレンスルホン酸、ト リエチルナフタレンスルホン酸、トリプロピルナフタレ ンスルホン酸、トリブチルナフタレンスルホン酸、カン フアースルホン酸、アクリルアミドー tーブチルスルホ 40 ン酸等を挙げることができる。

【0028】また、本発明においては、分子内に2つ以上のスルホン酸基を有する多官能有機スルホン酸も用いることができる。このような多官能有機スルホン酸としては、例えば、エタンジスルホン酸、プロパンジスルホン酸、ブタンジスルホン酸、ペンタンジスルホン酸、ヘキサンジスルホン酸、ヘプタンジスルホン酸、オクタンジスルホン酸、ノナンジスルホン酸、デカンジスルホン酸、ベンゼンジスルホン酸、ナフタレンジスルホン酸、トルエンジスルホン酸、エチルベンゼンジスルホン酸、トルエンジスルホン酸、エチルベンゼンジスルホン酸、

プロピルベンゼンジスルホン酸、ブチルベンゼンジスル ホン酸、ジメチルベンゼンジスルホン酸、ジエチルベン ゼンジスルホン酸、ジプロピルベンゼンジスルホン酸、 ジブチルベンゼンジスルホン酸、メチルナフタレンジス ルホン酸、エチルナフタレンジスルホン酸、プロピルナ フタレンジスルホン酸、ブチルナフタレンジスルホン 酸、ペンチルナフタレンジスルホン酸、ヘキシルナフタ レンジスルホン酸、ヘプチルナフタレンジスルホン酸、 オクチルナフタレンジスルホン酸、ノニルナフタレンジ スルホン酸、ジメチルナフタレンジスルホン酸、ジエチ ルナフタレンジスルホン酸、ジプロピルナフタレンジス ルホン酸、ジブチルナフタレンジスルホン酸、ナフタレ ントリスルホン酸、ナフタレンテトラスルホン酸、アン トラセンジスルホン酸、アントラキノンジスルホン酸、 フェナントレンジスルホン酸、フルオレノンジスルホン 酸、カルバゾールジスルホン酸、ジフエニルメタンジス ルホン酸、ビフエニルジスルホン酸、ターフェニルジス ルホン酸、ターフェニルトリスルホン酸、ナフタレンス ルホン酸-ホルマリン縮合物、フェナントレンスルホン 酸ーホルマリン縮合物、アントラセンスルホン酸ーホル マリン縮合物、フルオレンスルホン酸-ホルマリン縮合 物、カルバゾールスルホン酸ーホルマリン縮合物等を挙 げることができる。芳香環におけるスルホン酸基の位置 は任意である。

8

【0029】更に、本発明において、有機酸はポリマー 酸であってもよい。このようなポリマー酸としては、例 えば、ポリビニルスルホン酸、ポリビニル硫酸、ポリス チレンスルホン酸、スルホン化スチレンーブタジエン共 重合体、ポリアリルスルホン酸、ポリメタリルスルホン 酸、ポリー2-アクリルアミド-2-メチルプロパンス ルホン酸、ポリハロゲン化アクリル酸、ポリイソプレン スルホン酸、N-スルホアルキル化ポリアニリン、核ス ルホン化ポリアニリン等を挙げることができる。ナフィ オン(米国デユポン社登録商標)として知られている含 フッ素重合体も、ポリマー酸として好適に用いられる。 【0030】本発明においては、上記のようなプロトン 酸からなるドーパントを製膜溶液に含有させる方法とし て、特開平3-28229号公報に示されるように、例 えば、トリエチルアミンのような塩基性物質をドーパン トと共に加える方法も、好適に用いることができる。

【0031】このようなプロトン酸は、前記一般式 (I)で表わされるポリアニリンのキノンジイミン構造 のイミン窒素へのプロトン化によって、ポリアニリンを 導電性とする。通常、前述したように、アニリンを溶液 中で酸化重合して得られる前記一般式 (I)で表わされるキノンジイミン・フェニレンジアミン型のポリアニリンにおいては、式中、mとnの値はほぼ相等しい。 【0032】このように、キノンジイミン・フェニレンジアミン型のポリアニリンは、キノンジイミン構造を多

50 く有するので、プロトン酸によるドーピングによって、

ては、式

[0033]

【化2】

【0034】で表わされるイミノーpーフェニレン構造 単位を主たる繰返し単位として有する溶剤可溶性のポリ アニリン(以下、イミノーpーフェニレン型のポリアニ 10 リンということがある。)は、上記キノンジイミン・フ ェニレンジアミン型のポリアニリンに比べて、種々の有 機溶剤に一層よく溶解するので、上記キノンジイミン・ フェニレンジアミン型のポリアニリンと共に、又は上記 キノンジイミン・フェニレンジアミン型のポリアニリン に代えて、用いることができる。

【0035】このようなイミノーローフェニレン型のポ リアニリンは、特開平3-52929号公報に記載され ているように、前記キノンジイミン・フェニレンジアミ ン型のポリアニリンを還元剤にて還元することによって 20 得ることができる。本発明においては、このようなイミ ノーp -フェニレン型のポリアニリンも、N-メチルピ ロリドン中、30℃で測定した極限粘度〔ヵ〕が0.40 d1/g以上であることが好ましい。

【0036】上記還元剤としては、フェニルヒドラジ ン、ヒドラジン、ヒドラジン水和物、硫酸ヒドラジン、 塩酸ヒドラジン等のヒドラジン化合物、水素化リチウム アルミニウム、水素化ホウ素リチウム等の還元性水素化 金属化合物等が好適に用いられる。還元反応後に残渣を 生じないので、ヒドラジン水和物又はフェニルヒドラジ 30 ンが還元剤として特に好ましく用いられる。

【0037】このようなイミノーローフェニレン型のポ リアニリンを用いるときは、これを含む製膜溶液を基材 上にキャステイングし、基材上に上記製膜溶液の層を形 成し、加熱して、基材上に樹脂シートを形成し、次い で、その樹脂シートを基材から剥離し、その後、この樹 脂シートを更に加熱して、ポリアミド酸をイミド化させ る際に、空気酸化によって、キノンジイミン・フェニレ ンジアミン型のポリアニリンとなり、製膜溶液がドーパ ントを含むときは、このキノンジイミン・フェニレンジ 40 アミン型のポリアニリンをドーピングして、導電性のポ リアニリンを形成し、半導電性の樹脂シートを与える。 【0038】本発明による半導電性樹脂シートの形状は 特に限定されるものではなく、前述したように、平面的 若しくは曲面を有するシート状のほか、チューブ状であ ってもよい。また、不連続であっても、連続していても よい。

[0039]

【発明の効果】本発明によれば、以上のように、ポリイ ミドと脱ドープ状態のポリアニリンと(このポリアニリ 50 浄し、室温で真空乾燥して、硫酸にてドープされた導電

10

ンをドーピングして導電性とすることができるドーパン トと)を含む製膜溶液から製膜することによって、簡単 にポリイミドと(脱)ドープ状態のポリアニリンとのポ リマーブレンドからなる半導電性樹脂シートを得ること ができる。

【0040】特に、本発明に従って、脱ドープ状態のポ リアニリンを用いて得られる半導電性樹脂シートは、本 来、ドーパントを含まないために、水分等の環境条件の 変動にかかわらず、その半導電性は実質的に一定であ る。他方、本発明に従って、脱ドープ状態のポリアニリ ンとこのポリアニリンをドーピングして導電性とするド ーパントを含む製膜溶液を用いて、半導電性樹脂シート とするときは、製膜後にドーピングする方法と異なり、 製膜によって、直ちに、半導電性樹脂シートを得ること ができ、しかも、得られる半導電性樹脂シートにおいて は、ドーパントが水分や熱等の環境の影響によって脱ド ープし難く、かくして、環境に対して安定した半導電性 を有する。

[0041]

(6)

【実施例】以下に参考例と共に、実施例を挙げて本発明 を説明するが、本発明はこれら実施例により何ら限定さ れるものではない。

【0042】参考例1

(アニリンの酸化重合によるドープ状態のポリアニリン の製造) 攪拌装置、温度計及び直管アダプターを備えた 10リットル容量セパラブル・フラスコに蒸留水600 0g、36%塩酸360ml及びアニリン400g(4.2 95モル)をこの順序にて仕込み、アニリンを溶解させ た。別に、氷水にて冷却しながら、ビーカー中の蒸留水 1493gに97%濃硫酸434g(4.295モル)を 加え、混合して、硫酸水溶液を調製した。この硫酸水溶 液を上記セパラブル・フラスコに加え、フラスコ全体を 低温恒温槽にて-4℃まで冷却した。

【0043】次に、ビーカー中にて蒸留水2293gに ペルオキソ二硫酸アンモニウム980g(4.295モ ル)を加え、溶解させて、酸化剤水溶液を調製した。フ ラスコ全体を低温恒温槽で冷却して、反応混合物の温度 を-3℃以下に保持しつつ、攪拌下にアニリン塩の酸性 水溶液に、チュービングポンプを用いて、直管アダプタ ーから上記ペルオキソニ硫酸アンモニウム水溶液を1ml /分以下の割合にて徐々に滴下した。 最初、無色透明の 溶液は、重合の進行に伴って緑青色から黒緑色となり、 次いで、黒緑色の粉末が析出した。この粉末析出時に反 応混合物において温度の上昇がみられるが、反応系内の 温度を-3℃以下に抑えた。かくして、7時間を要し て、ペルオキソ二硫酸アンモニウム水溶液の滴下を終了 した後、更に1時間、-3℃以下の温度にて攪拌を続け

【0044】得られた粉末を沪別し、水洗、アセトン洗

性ポリアニリン430gを黒緑色の粉末として得た。 (ドープ状態の導電性ポリアニリンのアンモニアによる脱ドーピング)上記ドープ状態の導電性ポリアニリン粉末350gを2Nアンモニア水4リットル中に加え、オートホモミキサーにて回転数5000rpmにて5時間攪拌した。混合物は、黒緑色から青紫色に変化した。ブフナー漏斗にて粉末を沪別し、ビーカー中に攪拌しながら、蒸留水にて沪液が中性になるまで繰り返し洗浄し、続いて、沪液が無色になるまでアセトンにて洗浄した。この後、粉末を室温にて10時間真空乾燥して、黒褐色の脱ドープされたポリアニリン粉末280gを得た。【0045】参考例2

(ポリイミド前駆体溶液Aの調製)3,3',4,4' ービフェニルテトラカルボン酸二無水物とpーフェニレンジアミンのほぼ等モル混合物をNーメチルー2ーピロリドン溶液(濃度20重量%)中で温度20~60℃で12時間反応させて、粘度1000ポイズ(温度25℃、B型粘度計での測定値)、固定粘度2.1のポリアミド酸溶液を調製した。

【0046】(ポリイミド前駆体溶液Bの調製)ピロメリット酸二無水物と3,3',4,4'ージアミノジフェニルエーテルのほぼ等モル混合物をNーメチルー2ーピロリドン溶液(濃度20重量%)中で温度5~20℃で10時間反応させて、粘度2000ポイズ(温度25℃、B型粘度計での測定値)、固有粘度2.5のポリアミド酸溶液を調製した。

【0047】実施例1

Nーメチルー2ーピロリドン180gにフェニルヒドラジン2.98gを溶解させ、次いで、参考例1にて得られたポリアニリン粉末20gをこれに溶解させて、10重 30量%の脱ドープ状態のポリアニリン溶液を得た。次いで、このポリアニリン溶液に参考例2にて得られたポリイミド前駆体溶液A100gを添加し、1時間攪拌して、脱ドープ状態のポリアニリンとポリイミド前駆体とからなる製膜溶液を得た。

【0048】この製膜溶液を用いて、次のようにして製膜した。即ち、上記製膜溶液を120μmのギャップのナイフコーターを用いてガラス板上にコーティングした後、150℃で20分、200℃で20分、250℃で20分、最後に300℃で20分処理して、溶剤除去と40イミド化を行なった後、ガラス板から剥離して、脱ドープ状態のポリアニリンとポリイミドとのポリマーブレンドからなる厚さ15μmの半導電性樹脂シートを得た。【0049】この半導電性樹脂シートは、脱ドープ状態のポリアニリン50重量%とポリイミド50重量%とからなり、体積抵抗率は3×10¹¹Ω・cmであり、引張試験の結果、強度24kgf/mm²、弾性率520kgf/mm²であった。

【0050】実施例2

実施例1と同様にして10重量%濃度の脱ドープ状態の 50 %ドデシルベンゼンスルホン酸溶液を調製した。次い

ポリアニリン溶液200gを調製した。次いで、このポリアニリン溶液に参考例2で得られたポリイミド前駆体溶液B300gを添加し、1時間攪拌して、脱ドープ状態のポリアニリンとポリイミド前駆体とからなる製膜溶液を得た。

12

【0051】この製膜溶液を用いて、次のようにして製膜した。即ち、上記製膜溶液を240μmのギャップのナイフコーターを用いてガラス板上にコーティングした後、実施例1と同様にして、溶剤除去とイミド化を行なった後、ガラス板より剥離して、ポリイミドと脱ドープ状態のポリアニリンとのポリマーブレンドからなる厚さ30μmの半導電性樹脂シートを得た。

【 0052】この半導電性樹脂シートは、脱ドープ状態のポリアニリン25重量%とポリイミド75重量%とからなり、体積抵抗率は $4\times10^{12}\,\Omega$ ・cmであり、引張試験の結果、強度 $16\,kgf/mn^2$ 、弾性率 $260\,kgf/mn^2$ であった。

【0053】実施例3

実施例1と同様にして、10重量%濃度の脱ドープ状態 20 のポリアニリン溶液200gを調製した。別に、pートルエンスルホン酸一水和物(ドーパント)12.6gをNーメチルー2ーピロリドン113.5gに溶解して、10重量%pートルエンスルホン酸溶液を調製した。次いで、これらの2つの溶液を混合して、ドープ状態のポリアニリンの溶液を調製した。

【0054】この溶液に参考例2で得られたポリイミド前駆体溶液A100gを添加した後、1時間攪拌して、ドープ状態のポリアニリンとポリイミド前駆体とからなる製膜溶液を得た。この製膜溶液を240μmのギャップのナイフコーターでガラス板上にコーティングした後、150℃で30分間、加熱して、溶剤を除去した。このようにして得られたシートをガラス板から剥離し、300℃で20間加熱して、ポリイミドとpートルエンスルホン酸でドープされたポリアニリンとからなるポリマーブレンドの厚さ25μmの半導電性樹脂シートを得た。

【0055】この半導電性樹脂シートは、ドープ状態のポリアニリン50重量%とポリイミド50重量%とからなり、厚さ 25μ mであった。この半導電性樹脂シートの体積抵抗率を測定したところ、 $8\times10^{10}\,\Omega$ ・cmであった。また、表面抵抗を測定したところ、 $2\times10^9\,\Omega$ \Box であった。上記半導電性シートを蒸留水中に24時間浸漬した。乾燥させた後、体積抵抗率を測定したところ、 $1\times10^{11}\,\Omega$ ・cmであった。

【0056】実施例4

実施例1と同様にして、10重量%濃度の脱ドープ状態のポリアニリン溶液200gを調製した。別に、ドデシルベンゼンスルホン酸(ドーパント)21.5gをN-メチルー2-ピロリドン193.5gに溶解して、10重量%ドデシルベンゼンスルホン酸溶液を調製した。次い

13

で、これらの2つの溶液を混合して、ドープ状態のポリ アニリンの溶液を調製した。

【0057】この溶液に参考例2で得られたポリイミド 前駆体溶液Aを100gを添加した後、1時間攪拌し て、ドープ状態のポリアニリンとポリイミド前駆体とか らなる製膜溶液を得た。この製膜溶液を240μmのギ ャップのナイフコーターでガラス板上にコーティングし た後、150℃で30分間、加熱して、溶剤を除去し た。このようにして得られたシートをガラス板から剥離 ベンゼンスルホン酸でドープされたポリアニリンとから なるポリマーブレンドの厚さ25μmの半導電性樹脂シ ートを得た。

【0058】この半導電性樹脂シートは、ドープ状態の ポリアニリン50重量%とポリイミド50重量%とから なり、厚さ25μmであった。この半導電性樹脂シート

14

の体積抵抗率を測定したところ、2×10¹¹Ω·cmであ った。また、表面抵抗を測定したところ、 $2 \times 10^{10} \Omega$ /□であった。

【0059】比較例1

蒸留水400gにpートルエンスルホン酸100gを溶 解させ、これにメタノール500gを加えて、ドーパン ト溶液を調製した。このドーパント溶液に実施例1で得 られたポリイミドと脱ドープ状態のポリアニリンとのポ リマーブレンドからなる半導電性樹脂シートを60時間 し、300℃で20間加熱して、ポリイミドとドデシル 10 浸漬して、ポリアニリンのドーピングを行なった。得ら れた樹脂シートの体積抵抗率を測定したところ、7×1 O¹0Ω·cmであった。また、この樹脂シートを実施例5 と同様にして蒸留水中に24時間浸漬し、乾燥させた 後、表面抵抗を測定したところ、 $9 \times 10^{11} \Omega \cdot cm$ であ った。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号 FI

技術表示箇所

// B29L 7:00

CLIPPEDIMAGE= JP408259709A

PAT-NO: JP408259709A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08259709 A

TITLE: SEMICONDUCTOR RESIN SHEET AND PRODUCTION THEREOF

PUBN-DATE: October 8, 1996

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

UETANI, YOSHIHIRO NAKAMURA, MASAO

ABE, MASAO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NITTO DENKO CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP07067513

APPL-DATE: March 27, 1995

INT-CL (IPC): C08J005/18; B29C041/12; C08K005/42;

C08L079/00 ; H01B001/12

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a high elasticity modulus resin sheet which has stable

semiconductivity even under fluctuating environmental conditions and is

suitable for use as an electrode material for batteries, etc., by forming a

film from a solution containing a polyimide precursor and an undoped polyaniline.

CONSTITUTION: A solution containing a polyamic acid and an undoped polyaniline

is cast on a substrate to form a layer of the solution. The layer is heated to

60-200°C to form a resin sheet on the substrate. The sheet is peeled off

and then heated to 250-400°C to imidize the polyamic acid. Thus, the

objective sheet is obtained which comprises a blend of a polyimide and an

undoped polyaniline, and has a modulus of elasticity of

200kgf/mm<SP>2</SP> or higher and a volume resistivity of 10<SP>7</SP>-10<SP>14</SP>Ω.cm. Since the sheet contains no dopants, the semiconductivity thereof is stable even when environmental conditions including humidity fluctuate.

COPYRIGHT: (C) 1996, JPO